

174ПС2

ДВОЙНОЙ БАЛАНСНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

СХЕМА НЕСИММЕТРИЧНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОСХЕМЫ

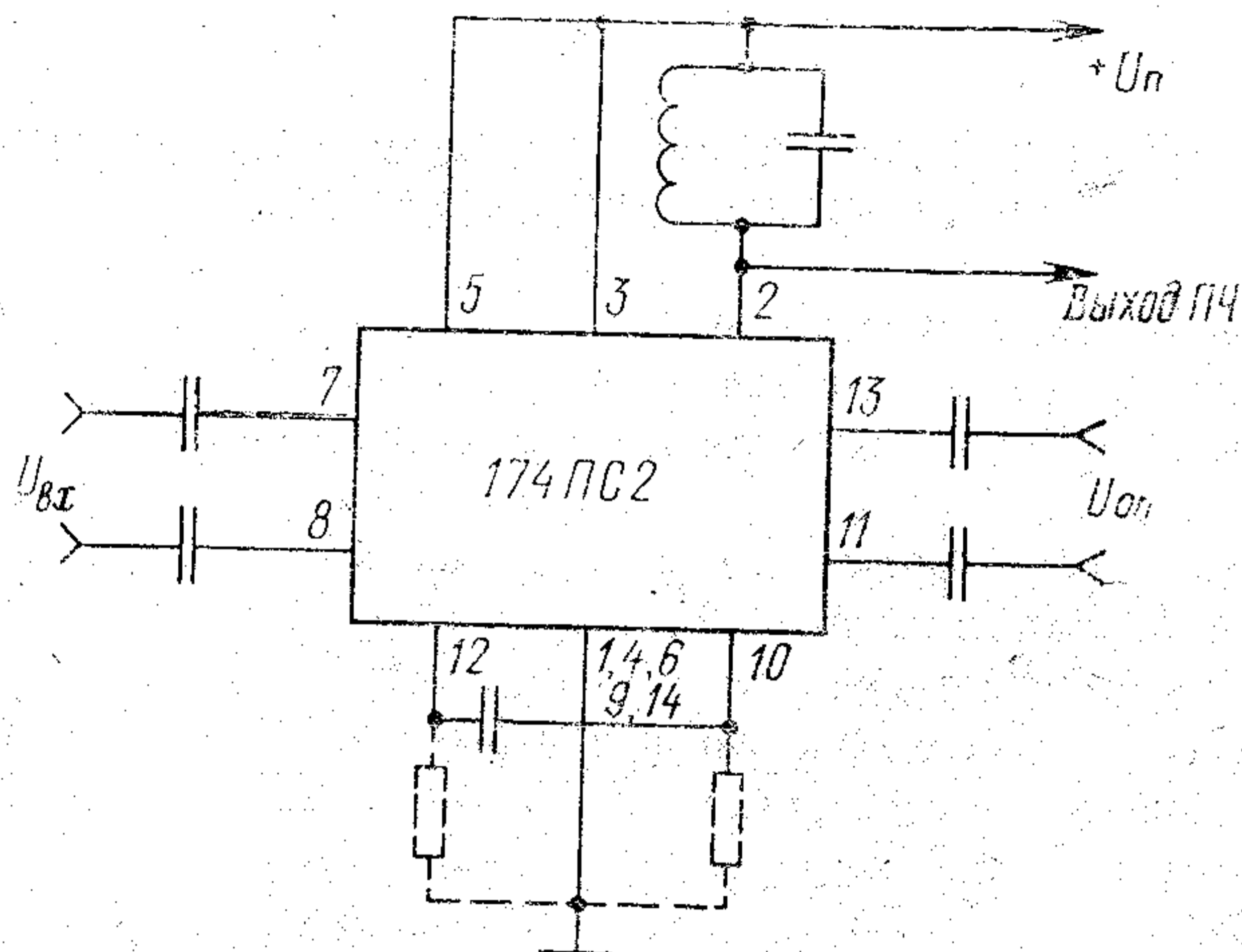
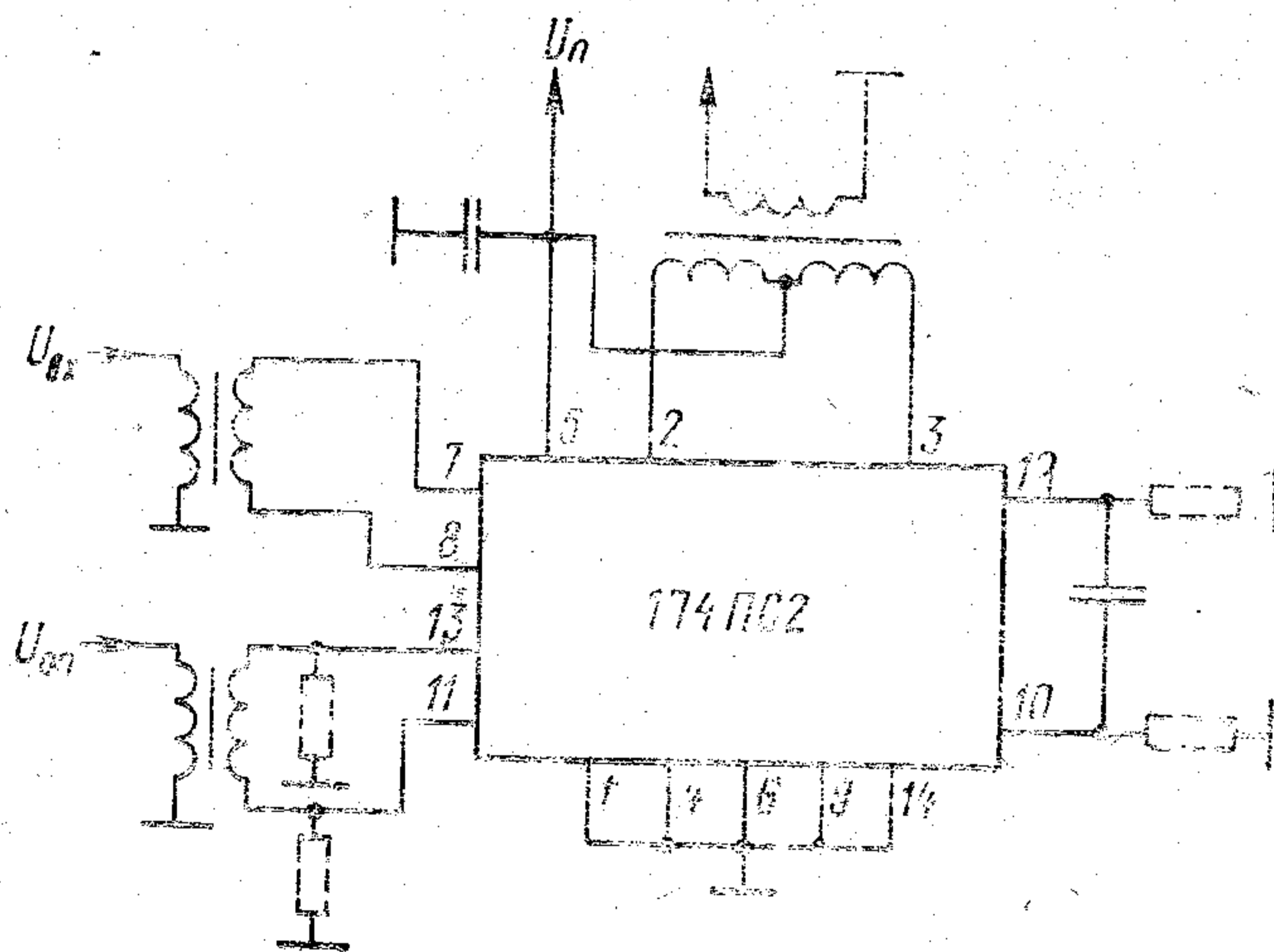


СХЕМА СИММЕТРИЧНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОСХЕМЫ



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре $25 \pm 10^\circ\text{C}$)

Напряжение питания, В	$6 \pm 10\%$
Ток потребления, мА, не более	3,5
Коэффициент ослабления входного напряжения, дБ, не менее	30
Коэффициент ослабления опорного напряжения, дБ, не менее	30
Коэффициент шума, дБ, не более	8
Динамический диапазон по напряжению, дБ, не менее:	
ΔU_1 при $U_{\text{п}}=6$ В	83
ΔU_2 при $U_{\text{п}}=10$ В	106
Крутизна преобразования, мА/В, не менее:	
$S_{\text{соп1}}$ при $U_{\text{оп}}=150$ мВ, $f_{\text{вх}}=3$ МГц, $f_{\text{оп}}=2,8$ МГц	5
$S_{\text{соп2}}$ при $U_{\text{оп}}=300$ мВ, $f_{\text{вх}}=200$ МГц, $f_{\text{оп}}=210,7$ МГц	10
$S_{\text{соп3}}$ при $U_{\text{оп}}=300$ мВ, $f_{\text{вх}}=500$ МГц, $f_{\text{оп}}=510,7$ МГц	4

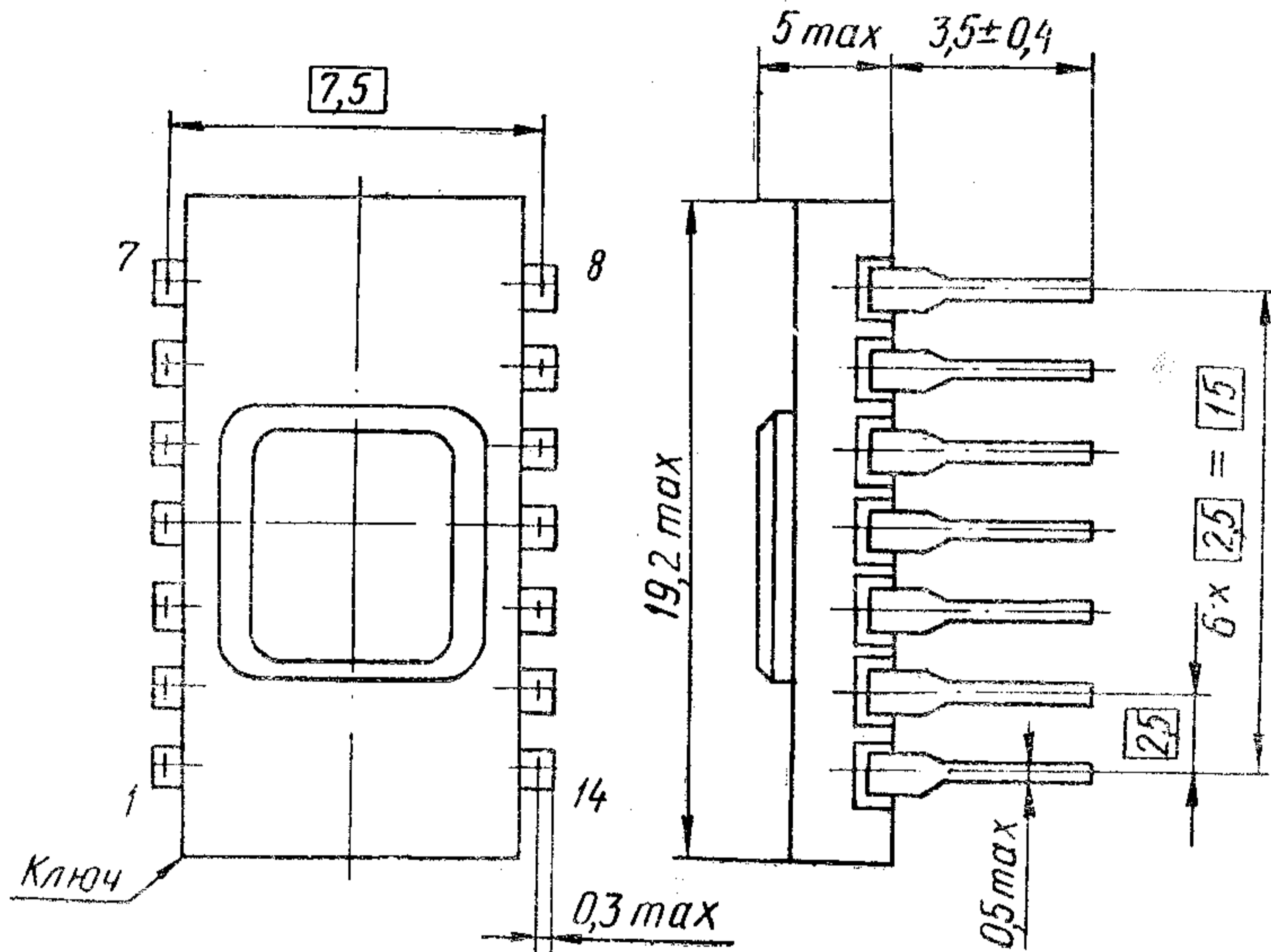
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение питания, В:	
максимальное	6,6
минимальное	5,4
Максимальное входное напряжение, В	0,5
Максимальное опорное напряжение, В	0,5
Максимальная частота входного напряжения, МГц	500
Максимальная частота опорного напряжения, МГц	510,7
Минимальное сопротивление нагрузки по переменному току, Ом	1
Минимальное сопротивление, Ом:	
между выводами 10 и 1	220
» » 12 и 1	220

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 174

Общие данные

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ МИКРОСХЕМЫ 174ПС2 (КОРПУС 201.14-10)



ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц	от 1 до 5000
амплитуда ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	400 (40)

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	15 000 (1500)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 0,1 до 2,0

Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5

Линейное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g) 5000 (500)

Атмосферное пониженное давление, мм рт. ст. (Па) 10^{-6} ($1,3 \cdot 10^{-4}$)

Атмосферное повышенное давление, атм. 3

Повышенная температура среды, °C:

для микросхем 174ХА4, 174ХА5, 174ПС1, 174ХА2, 174УР9, 174ХА21	85
----------------------------------------------------------------------------	----

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 174

Общие данные

для микросхем 174УП2, 174УР7, 174ПС2, 174УВ1, 174ГФ2	125
для микросхемы 174ХА7	100
Пониженная температура среды, °С	минус 60
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка*, ч	50 000
Срок сохраняемости*, лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы серии 174 следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

Допустимое значение статического потенциала 200 В.

При эксплуатации должна быть предусмотрена защита микросхем от случайного кратковременного увеличения питающих напряжений, превышающих предельную величину.

При монтаже микросхем рекомендуется использовать минимальную длину соединений между выводами корпуса и навесными элементами для уменьшения влияния паразитных связей. Не допускается подавать электрические потенциалы на незадействованные выводы микросхем.

Микросхемы в блоках аппаратуры рекомендуется покрывать лаком УР-231 ТУ 6-10-863—84 или ЭП-730 ГОСТ 20 824—81, обеспечивающим лучшую работоспособность микросхем в условиях повышенной влажности, соляного тумана, инея с последующим его оттаиванием. Количество слоев лака — 3.

* В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.